



桂林斯壯桂微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

BAS70-05

SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管(BAS70-05)

■FEATURES 特點

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|-----------------------------|-------------|---------|
| Power dissipation 耗散功率 | $P_D(T_a=25^\circ\text{C})$ | 225 | mW |
| Forward Current 正向電流 | I_F | 70 | mA |
| Reverse Voltage 反向電壓 | V_R | 70 | V |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度 | T_J, T_{stg} | -55to+150°C | |

■DEVICE MARKING 打標

BAS70-05=75

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|--|--------------|------------|--------------------|---------------|
| Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=10\mu\text{A}$) | $V_{(BR)}$ | 70 | — | V |
| Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=50\text{V}$) ($V_R=70\text{V}$) | I_R | — | 0.1 10 | μA |
| Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=1\text{mA}_{dc}$ $I_F=10\text{mA}_{dc}$ $I_F=15\text{mA}_{dc}$ | V_F | — | 410 750 1000 | mV |
| Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=1\text{V}$, $f=1\text{MHz}$) | C_D | — | 2 | pF |
| Reverse Recovery Time 反向恢復時間 | T_{rr} | — | 5 | nS |

■SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

